

## 8.7 本章習題

---

1. 製程微縮後，所遭受的物理極限為何？有哪些重要的參數需要注意？
2. 試比較 MOS 元件特性在 SOI 及 Bulk 基材間的特性差異。
3. 試述完全空乏 SOI 與不完全空乏 SOI 的特性比較。
4. 試述 local strain Si 在不同方向的拉伸應力時，載子移動的情形。
5. 試述應變矽在製程所遭遇的工程問題。
6. 試述形成高介電材料氧化層之上下介面應考慮的參數。
7. 試述高介電閘極氧化層所遭遇的工程問題。
8. 試述為何先進製程須導入金屬閘極。
9. 試述有哪些製程可完成金屬閘極。